

Spezifikationen	
Artikelnummer	TPD3215M
Hersteller	Transphorm
Beschreibung	CASCODE GAN HB 600V 70A MODULE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2611 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	-
Supplier Device-Gehäuse	Module
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 30A, 8V
Leistung - max	470W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Module
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2260pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 8V
Typ FET	GaNFET N-Channel, Gallium Nitride
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

sein:

sein:					
 TPD3E001DRLR N/A TVS DIODE SOT5	 TPD3E001DRL TI TI 2015+RoHS	 TPD2S701QDSKRQ1 N/A AUTOMOTIVE USB 2-CHANNEL DATA LI	 TPD2S703QDSKRQ1 N/A TVS MIXED TECHNOLOGY 6VC 10WS0N		
 TPD3E001DRLRG4 N/A TVS DIODE SOT5	 TPD3E001 TI	 TPD2S703Q1EVM N/A EVALI MOD	 TPD2S703QDGSRQ1 N/A TVS MIXED TECHNOLOGY 6VC 10VSSOP		

Mehr

Schlüsselwort

TPD3215M Neu TPD3215M Original TPD3215M garantiert TPD3215M RFQ TPD3215M Online bestellen